

InGaAs фотодетекторный чип 1310 нм, 1000 мкм — техническое описание

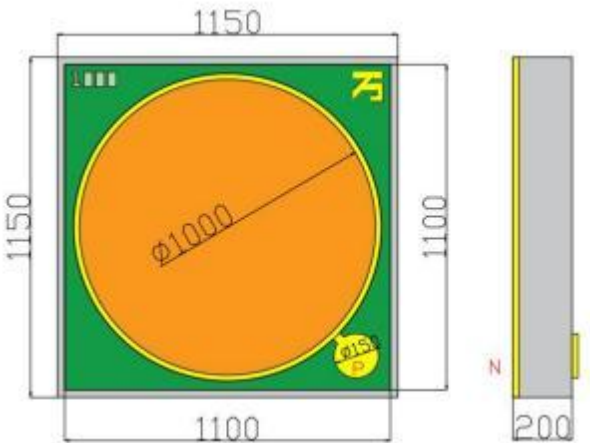
P/N : WIMA-1000

Применение

Оптические датчики; измерители оптической мощности

Структура

InGaAs/InP PIN-чип; P-электрод (анод): золото;
N-электрод (катод): золото



ГАБАРИТЫ

Габариты	Мин.	Тип.	Макс.	Ед. изм.
Активная область	995	1000	1005	мкм
Ширина чипа	1130	1150	1170	мкм
Длина чипа	1130	1150	1170	мкм
Высота чипа	180	200	220	мкм
Размер контактной площадки	140	150	160	мкм

Электрооптические характеристики (при Ta=25 °C)

Параметр	Обозначение	Условия измерения	Мин.	Тип.	Макс.	Ед. изм.
Темновой ток	Id	Vr=-5V	-	0.5	2.5	нА
Емкость	Cp	Vr=-5V	-	55	65	пФ
Напряжение обратного смещения	Vbr	Ir=-10μA	20	38	60	В
Чувствительность	R	@1310 nm	0.8	0.9	-	А/Вт
Рабочий диапазон длин волн	λ		900	1310	1600	нм

Примечание: ESD (HBM) > 800 В

ПРЕДЕЛЬНО ДОПУСТИМЫЕ ПАРАМЕТРЫ

Параметр	Значение
Рабочая температура	от -40 °C до +85 °C
Температура хранения	от -55 °C до +125 °C
Прямой ток	10 мА